DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2002 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

007876702

WPI Acc No: 1989-141814/ 198919

XRAM Acc No: C89-062906 XRPX Acc No: N89-108212

Dispersant for polishers - comprises polystyrene sulphonic

acid or its salts

Patent Assignee: LION CORP (LIOY)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 1087146 A 19890331 JP 87238543 A 19870922 198919 B

Priority Applications (No Type Date): JP 87238543 A 19870922

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 1087146 A 5

Abstract (Basic): JP 1087146 A

The dispersant comprises polystyrene sulphonic acid or its salts. The polystyrene sulphonic acid or its salt pref. has a mol. wt. of 3,000-1,000,000 esp. 5,000-500,000. The salt is pref. e.g. Na, K, ammonium, monoethanolamine, diethanolamine, and triethanolamine. The amt. of the polystyrene sulphonic acid or the salts is pref., 0.01-5% by wt., esp. 0.05-3% in the polishing soln. Pref. abrasives for incorporation in the polishing soln. are oxides of Ce, Zr, Sn, Cr, and Fe or powdered diamone, alumina, SiC, TiO2, SiO2, Zr-silicate. Al-silicate, BN, or Si 3N4.

USE-ADVANTAGE - Polishes are obtd. having high stability over a long storage time maintaining excellent dispersibility. Improved rate of polishing and reduced surface damage are also obtd. and good operability and surface finish are achieved. It is suitable for polishing electronic materials e.g. Si wafers, hard disks, silica substrates, quartz oscillators, etc., and also, for polishing glass, ceramics, and metal.

0/0

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-87146

<pre>⑤Int Cl.⁴</pre>	識別記号	庁内整理番号		43公開	昭和64年(198	39)3月31日
B 24 B 37/00 C 08 F 12/30 C 08 L 25/04 C 09 K 3/14	M J Y L E J	H-7712-3C 7445-4 J 7445-4 J X-6683-4 H	審査請求	未請求	発明の数 1	(全5頁)

9発明の名称 研磨剤用分散剤

②特 頭 昭62-238543

②出 願 昭62(1987)9月22日

②発明者小沢利之神奈川県茅ケ崎市下町屋3-1-30-204

⑩出 願 人 ライオン株式会社 東京都墨田区本所1丁目3番7号

四代 理 人 并理士 臼村 文男 外1名

明 知 杏

1. 発明の名称

研磨剤用分散剤

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. ポリスチレンスルホン酸またはその塩からなることを特徴とする研磨剤用分散剤。
- 3. 発明の詳細な説明

技術分野

本発明は、研磨剤、特に高速、精密研磨に用いられる工業用研磨剤に好適な分散剤に関する。 <u>従来技術</u>

シリコーンウェーハ、ハードディスク、石英 芸板、水品 扱動子などの電子材料の研削加工、 表面仕上げや、その他硝子、セラミックスある いは金属素材の研削加工、表面仕上げに研磨剤 が汎く用いられている。

例えば、硝子用研磨剤としては、軟質の硝子 素材には酸化セリウムが、硬質の硝子素材には 酸化セリウムおよび酸化ジルコニウムが主に用 いられ、一般に粒子径1 μα前後の研磨剤を単 に水と混合するだけで使用している。

研磨剤に要求される三大要素は、、高研磨速度、低ダメージ、低コストであるが、近年の光学機器、電子機器の技術的進歩に伴ない、 硝子素材の需要も増大し、より迅速な研磨、 より精密な 仕上げの要望が高まっている。即ち、三大変を のうち前二者の技術的向上が重要な 練題として クローズアップされてきており、 これらら要求に 答える研磨システムの開発がまたれている。また、研磨剤が水とのサスペンション系として用いられることから、静置安定性、再分散性が要求される。

シリコーンウェーハ、ハードディスク、石英 拡板、水晶発振子といった電子材料用のラッピ ング剤としては主にアルミナ、アルミナと珪酸 ジルコニウム等の混合物、炭化ケイ素などが約 10~40%の濃度で使用されている。ラッピング 剤の粒子径は対象とする素材により異なるが、 例えばシリコンウェーハでは5~20μαのアル ミナ系ラッピング剤が用いられ、水晶振動子で

研磨剂に分散剤を配合することは、例えば特公昭43-21358号公報に、高分子型分散剤を配合して素材との"なじみ"を改良し、研磨後の仕上り、作業効果を改善することが提案されている。

また、希土類酸化物等の研磨剤にアルカリ金属またはアルカリ土類金属を添加し、分散性の改良、表面仕上げの改善を行なうことが協案さ

えばポリスチレンを常法により、硫酸、無水硫酸等のスルホン化剤で直接スルホン化した後、 未反応のポリスチレンを戸別することにより、 あるいはその後に水酸化ナトリウム、水酸化カ ルシウム等のアルカリ剤で中和することにより 得られる。

研磨剤と水との懸濁液に本発明のポリスチレンスルホン酸またはその塩を添加することにより、研磨剤組成物が得られる。ポリスチレンスルホン酸またはその塩は、研磨剤組成物中に0.01~5 重量%、好ましくは0.05~3 重量%添加するのが好適である。

研磨剤としては、酸化セリウム、酸化ジルコニウム、酸化スズ、酸化クロム、酸化鉄、ダイヤモンド粉末、アルミナ、炭化珪素、酸化チタン、二酸化珪素、珪酸ジルコニウム、珪酸アルミニウム、窒化ホウ素および窒化珪素から選ばれる1種または2種以上の研磨剤が好適である。研磨剤の水サスペンション中の濃度は、その研磨対象や仕様によって適宜決定される。

れている(特開昭50-13405号公報)。

発明の目的

発明の構成

本発明の研磨剤用分散剤は、ポリスチレンス ルホン酸塩またはその塩からなることを特徴と する。

以下、本発明についてさらに詳細に説明する。ポリスチレンスルホン酸またはその塩としては、分子量3,000~100万のものが好適であり、特に5,000~50万が好ましい。塩における対イオンとしては、ナトリウム、カリウム、アンモニウム、モノエタノールアミン、ジエタ グールアミン、トリエタノールアミン等が好適であり、カルシウム、マグネシウム等を用いることもできる。

ポリスチレンスルホン酸またはその塩は、例

. 発明の効果

本発明によれば、研磨剤を水懸濁液にして研磨するに際し、この分散剤としてポリスチレンスルホン酸またはその塩を添加することにより、研磨剤感濁液の高濃度での長期間にわたる静度安定性が得られるとともに、良好な再分散性を示す。しかも、研磨速度の向上および表面ダメージの低下など研磨特性に優れ、作業性ならびに面仕上げの両面に優れた特性を示す。

本発明の研磨剤用分散剤を用いる研磨方法は、 上記のような優れた特性を有し、特にシリコン ウェーハ、ハードディスク、石英基板、水晶摄 勁子などの電子材料用、あるいはその他の硝子 用、セラミックス用、金属用の研磨に好適であ る。

実施例1

オスカー型平面研磨機(馬渕商店製OM-200)を 使用して、不二見研磨剤工業のF0#1200(アルミナ質研磨剤)で10分間ラッピングを行ない、表 面相さや形状を均一化した100mm*、厚さ約30mm の円板状硝子素材(SK-16)を得た。

この硝子素材を、代表的な硝子用研磨剤であるCeO.を以下の表-1に示す組成物として用い、30分間ポリシングしたときの、研削量およびキラ傷の発生について評価した。

研削量は厚み計によりポリシング前後の厚み を測定し、キラ傷は64倍の実体顕微鏡で観察した。結果を表 - 1 に示す。

表-1

粗	研磨剤	組成物	ポリシ	ング結果
成	ポリシング剤	分散媒	研削量	キラ傷
Na			(μm/30 /})	
Α	10%酸化	水	5.6	悪い研磨条件
	セリウム			で発生
В	10%酸化	0.1%PSS-Na ^{#1}	7.0	同上条件でも
	セリウム	水溶液	ļ	なし
С	10%酸化	2%PSS-Na	6.8	同上条件でも
	セリウム	水溶液	į	なし
D	なし	2%PSS-Na	0.1以下	周上条件でも
		水溶液		なし

※1) PSS-Na:ポリスチレンスルホン酸ナトリウム(Nv=50,000)

PSS-Naのみを含む組成物には殆ど研削 力がなく、一方、PSS-Naとポリシング剤

工業のF0#1200で15分間ラッピングした場合の 研削量と表面租さを測定し、その結果を表ー 2 に示した。

研削量の測定法は実施例1と同じである。

また、表面租さは小坂研究所製の表面租さ計 (SP-11)を用いて測定し、その結果をコンピューターで計算して中心線平均租さ (Ra: μα)として表示した。

(以下余白)

の両方を含む組成 B および C は、ポリシング剤のみを含む組成 A よりも研削力が高いことから、ポリシング剤に P S S - N a が併用されることにより相頼的に研削力が改善されることが判る。

これは、ポリスチレンスルホン酸塩の優れた粒子分散力により、ポリシング剤である CeOzの沈降、凝集を抑え、研磨に関与する 有効なCeOzの無を増大し、かつ、有効な研 腔の効率を向上させるためと考えられる。

組成BおよびCより、ポリスチレンスルホン酸ナトリウムの濃度は0.1~2%の間で研削量に変化がないことも判る。

実施例2

スピードファム社のラッピング装置(98-5LP) を用いて、4インチ*、厚さ約500μmのシリコ ーンウェハー(アズカット品)を、不二見研磨剤

	田田田田田田	£ 5	ロジアングは田	
	阿姆斯西姆政协	K to	アン・アン・	4
l .	ラッピング 色	分散媒	研削量(nm/min)	Ra(µm)
l	25%F0#1200	*	4.6	0.18
1		0.5%PSS-Na		
	25%FO#1200	水溶液	5.2	0,16
1		0.5%PSS-Na		
	なっ	大站被	0.1以下	0.50

т С

(以下余白)

目盛付摺合せフタ付き試験管に、下記表 - 3

再分散の容易性は、試験管を一定条件で扱盪

し、試験管底部に沈降した粒子が失くなるまで

に示す研磨剤を分散媒に分散させ、2日後放置

後の再分散の容易性を評価した。

の振盪回数で表示した。

粗成Gはほとんど研削力が無く、組成Fは粗 成E+粗成Gよりも研削量が高いことから、ポリスチレンスルホン酸塩を用いることにより相 剰効果的な研削力が得られることが判る。

組成Gによる研磨後の表面租さは、租成Gには殆ど研磨力がないことから、アズカット品の表面租さにほぼ等しい数値と思われる。

一方、組成Fは、組成Eに比べて高研削量であるにも拘らず、より平滑な表面に仕上げるという好ましい特性を示すことも判る。通常は、研削量が高いほど、荒い面仕上げとなる。

これらの結果は、ポリスチレンスルホン酸塩の優れた粒子分散力により、ラッピング剤であるF0 11 200の沈降・凝集が抑えられ、研磨に関与する有効ラッピング剤量が増加するとともに、均一に分散された粒子により良好な面仕上げが遠成されたことを意味する。

実施例3

ポリスチレンスルホン酸塩の再分散性の向上 効果を評価した。

41 د 젌 寒 数 回 回 回 回 敗録に回 20 20 分 跟 庶 銰 未: 79 g PSS-Na: 1 靐 . 80 8 8 : 79 7K: 79 削組成物 \$ × ⊀ 趣 展 50 20 厗 20 70 鮂 · Ö F0#1200 臣 镃 H × 52

ಕ್ಷ 1 表-3の結果から、ポリスチレンスルホン酸塩を含有する研磨剂組成物は、再分散が容易であり、研磨廃液の処理、研磨液調製後の放置時間に気を使う必要がない為、作業性の面で優れ

実施例4

たものである。

以下の各処方の研磨剤組成物を調製した。これら組成物は研磨特性ならびに再分散性に優れていた。

① 組成 Na: L

酸化ジルコニウム 5% ポリスチレンスルホン酸 Na 0.05% 水 残 部

②組成 M: M

 炭化珪素
 30%

 ポリスチレンスルホン酸 Na
 1%

 水
 残

100%

③ 組成 Na : N

ي ا است

ダイヤモンド粉末 10% ポリスチレンスルホン酸 Na 0.5%

100%

④ 組成 Na : P

珪酸ジルコニウム 50% ポリスチレンスルホン酸 Na 3%

⑤組成 No : Q

酸化チタン 10% ポリスチレンスルホン酸 Na 0.5% 水 <u>残</u>部

100%

特許出願人 ライオン株式会社 代理人弁理士 日 村 文 原標 名